

# 2SB524

低周波電力増幅用  
シリコンPNPエピタキシャルプレーナ形

### 概要

2SB524は、シリコン樹脂封止形のシリコンPNPエピタキシャルプレーナ形パワートランジスタで、5~10W出力のホームステレオ等の出力用として、2SD361とコンプリメンタリで使用するのに最適です。

### 特長

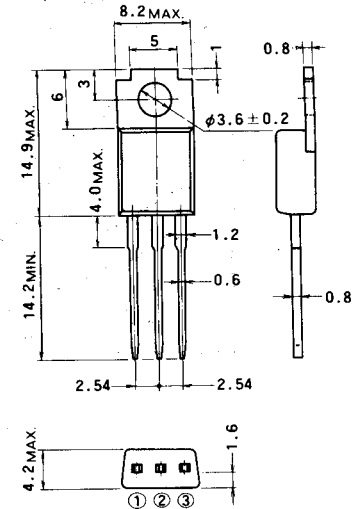
- 耐圧が高い  $V_{CE0} \geq -40V$
- 大電流での  $h_{FE}$  の低下が少ない
- コレクタ電流が大きい  $I_C = -1.5A$ 、 $I_{CM} = -3A$
- $V_{CE(sat)}$  が低い  $I_C = -1A$  で  $-1V$  以下

### 用途

ホームステレオ等の5~10W出力の低周波電力増幅回路

外形図

単位: mm



#### 電極接続

- ①: ベース EIAJ: -
- ②: コレクタ(放熱板) JEDEC: -
- ③: エミッタ

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。

### 最大定格 ( $T_0 = 25^\circ C$ )

記号	項目	定格値	単位	
$V_{CBO}$	コレクタ・ベース間電圧	-60	V	
$V_{EBO}$	エミッタ・ベース間電圧	-5	V	
$V_{CEO}$	コレクタ・エミッタ間電圧	-40	V	
$I_C$	コレクタ電流	-1.5	A	
$I_{CM}$	せん頭コレクタ電流	-3	A	
$P_C$	コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	1	W
		$T_0 = 25^\circ C$	10	W
$T_j$	接合部温度	150	$^\circ C$	
$T_{stg}$	保存温度	-55 ~ +150	$^\circ C$	

### 電気的特性 ( $T_0 = 25^\circ C$ )

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CBO}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -1mA, I_E = 0$	-60			V
$V_{(BR)EBO}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -1mA, I_C = 0$	-5			V
$V_{(BR)CEO}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -10mA, R_{BE} = \infty$	-40			V
$I_{CBO}$	コレクタシャ断電流	$V_{CB} = -25V, I_E = 0$			-1	$\mu A$
$I_{EBO}$	エミッタシャ断電流	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$			-1	$\mu A$
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V, I_C = -0.5A$ , パルス測定	55	110	300	-
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -1A, I_B = -0.05A$			-1	V
$V_{BE}$	ベース・エミッタ間電圧	$V_{CE} = -4V, I_C = -0.05A$		-0.7		V

†:  $h_{FE}$  の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	C	D	E
$h_{FE}$	55~110	90~180	150~300